ウ　シリコン又はシリコンゲルマニウムのエピタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの

（削る）

（一）・（二）　（略）

ヰ　厚さが二マイクロメートル超であり、かつ、密度が一立方センチメートル当たり一・七グラム超のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ　（略）

オ　金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置（キ（三）に該当するものを除く。）

ク～フ　（略）

コ　プラズマドーピング用に設計されたイオン注入装置のうち、次の全てに該当するもの

（一）　高周波の出力の電源を一以上有するもの

（二）　パルス直流電源を一以上有するもの

（三）　少なくともN型又はP型のいずれかの不純物の注入が可能なもの

エ　深紫外液浸フォトリソグラフィ装置において、又は、深紫外液浸フォトリソグラフィ装置とともに、次のいずれかを実施するように設計又は改造した装置

（一）　次の全てに該当するもの

1　深紫外液浸フォトリソグラフィ装置のナノメートルで表した光源の波長に〇・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値を四五以下に減少させるもの

2　深紫外液浸フォトリソグラフィ装置の重ね合わせ精度を二・四ナノメートル以下にするもの

（二）　ヘ（一）2又はヲに該当する露光装置の任意の時間間隔における一時間当たりのウエハーを処理する枚数を平均で一パーセント以上増加させるように設計又は改造したもの

テ　インプリントリソグラフィ装置であって、四・〇ナノメートル以下の重ね合わせ精度を有するもの

ア　エッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　異方性ドライエッチング用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの

1　二以上の独立した高周波の電源を有するもの

2　二以上の独立したガスの供給源を有するもの

3　ウエハーの厚みの不均一性を補正するためのプロセス均一性調整機能を有するもの

4　シリコン貫通電極の露出工程の終点検出の機能を有するもの

（二）　異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が高い形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの（カ（二）、ヨ、タ、ア（一）又はサに該当するものを除く。）

1　エッチングの幅に対する深さの比率が三〇を超えるもの

2　エッチングの幅の上面の寸法が四〇ナノメートル未満のもの

ウ　シリコン（炭素を添加したものを含む。）又はシリコンゲルマニウム（炭素を添加したものを含む。）のエピタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの

（一）　複数のチャンバーを有し、かつ、複数の工程間において〇・〇一パスカル以下の真空状態又は水と酸素の分圧が〇・〇一パスカル未満の不活性な環境を維持することができるもの

（二）・（三）　（略）

ヰ　厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ　（略）

オ　金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置

ク～フ　（略）

（新設）

（新設）

（新設）